

2SD1414

シリコンNPNエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)(ダーリントン接続)

- スイッチング用
- ハンマードライブ、パルスモータードライブ用
- 電力増幅用

通信工業用

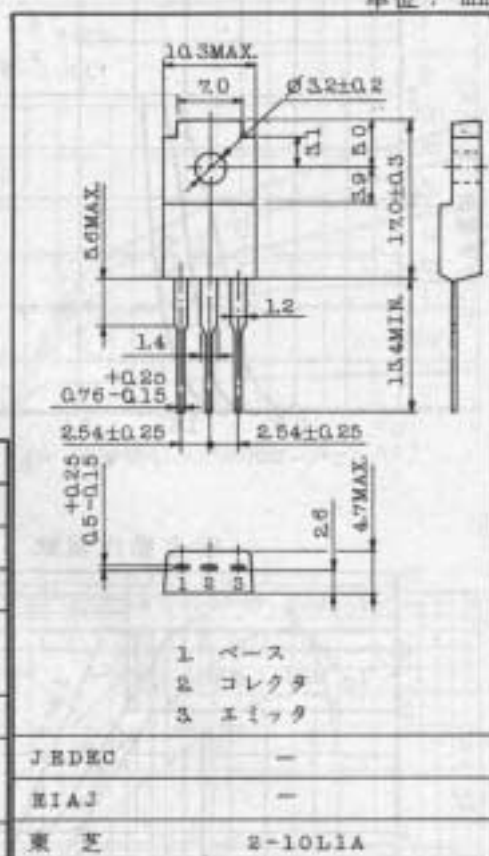
単位: mm

特長

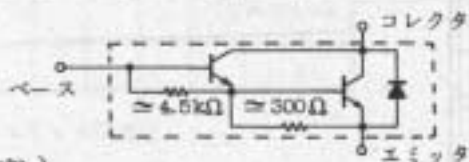
- ・ 直流電流増幅率が高い。
: $h_{FE} = 2000$ (最小) ($V_{CE} = 2V, I_C = 1A$)
- ・ 飽和電圧が低い。: $V_{CE(sat)} = 1.5V$ (最大) ($I_C = 3A$)
- ・ 2SB1024とコンプリメンタリになります。

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	DC	I_C	4
	パルス	I_{CP}	6
ベース電流	I_B	0.5	A
コレクタ損失	$T_a = 25^\circ C$	P_C	20
	$T_c = 25^\circ C$		20
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ 150	$^\circ C$



等価回路



電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタしき断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 100V, I_B = 0$	-	-	20	μA
エミッタしき断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$	-	-	25	mA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 10mA, I_B = 0$	80	-	-	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = 2V, I_C = 1A$	2000	-	-	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = 2V, I_C = 3A$	1000	-	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 3A, I_B = 6mA$	-	-	1.5	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 3A, I_B = 6mA$	-	-	2.0	V
スイッチング時間	ターンオン時間	t_{on}	-	0.2	-	μs
	蓄積時間	t_{stg}	-	1.5	-	
	下落時間	t_r	-	0.6	-	

